Солитоны в двумерных и трехмерных кристаллах при ферми-резонансе оптических колебаний

© О.А. Дубовский, А.В. Орлов

Физико-энергетический институт, 249020 Обнинск, Калужская обл., Россия

(Поступила в Редакцию 20 июля 1998 г.)

Показано, что в двумерных и трехмерных кристаллических системах типа сверхрешеток при фермирезонансе колебаний граничащих кристаллов существуют солитонные возбуждения пикового, кратерного и темнового типов, найденные авторами ранее только в одномерных кристаллах. Приведено аналитеческое решение для центральной части огибающих солитонов. Численный расчет дал совпадающие с аналитическим решением результаты в центральной части солитонов и показал наличие отсутствующих у одномерных кристаллов пульсаций огибающих на крыльях пиковых и кратерных солитонов в двумерных и трехмерных кристаллах.

В настоящее время ведутся экспериментальные и теоретические исследования нелинейных оптических колебаний в органических сверхрешетках с программируемым чередованием монослоев органических молекул, разрабатываются новые технологии изготовления многослойных сверхрешеток для нелинейных оптических устройств, которые в преспективе могут быть использованы для создания оптического компьютера [1-3]. В [4-6] обращено внимание на важную роль фермирезонанса (ФР) оптических колебаний в контактирующих кристаллических плоскостях, при котором энергия $\hbar\omega_{C}$ экситона в одной из плоскостей близка к суммарной энергии 2 ћ ω_B двух экситонов в соседней плоскости. В [6-9] было показано, что в таких системах, типа сверхрешеток, вдоль интерфейса могут распространяться специфические смешанные BB + C экситонные возбуждения (FRIM, Fermi Resonance Interface Modes) [6], эти квантовые и классические FRIM определяют бистабильность [7] и, возможно, генерирование нелинейных солитонных возбуждений — многочастичных комплексов из FRIM состояний [8-10]. При этом в [8-10] в предположении гладкости огибающих солитонов, дающем возможность использования соответствующих нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка, для модельных одномерных кристаллических систем были получены солитонные решения с гладкими монотонными огибающими типа известного гиперболического косинуса. В работах авторов [11,12] при исследовании солитонных возбуждений FRIM типа в одномерных замкнутых кристаллических цепочках с возрастающей длиной было показано, что солитонные возбуждения того типа, который был найден ранее в [8-10] при решении соответствующих нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка, являются отдельным элементом целого класса солитонных возбуждений, имеющих различные виды симметричных [11] и антисимметричных [12] огибающих. При этом в [11,12] было показано, что в отличие от [8-10] несущая частота солитона не является фиксированной величиной, а может с определенным порогом варьироваться при соответствующем изменении огибающей. Результаты работ [11,12] были использованы в последнее время в [13,14] уже при более глубоком исследовании солитонов различных типов, найденных в [11,12], с использованием соответствующих нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка. В связи с усиливающимся интересом к найденным в [11,12] солитонным возбуждениям представляется необходимым теперь уже более детальное изучение этих возбуждений в реальных, экспериментально исследуемых кристаллических системах — на двумерных интерфейсах, в плоских сверхрешетках [10], в трехмерных кристаллах с ферми-резонансом мономеров [15] и т.д. Отметим, что ФР может также оказывать существенное влияние на спектры оптических и акустических многофононных колебаний в легких металлах типа бериллия [16].

В настоящей работе исследуются нелинейные возбуждения FRIM типа в реальных двумерных (2D) и трехмерных (3D) кристаллических системах. Рассматриваются, во-первых, 2D-системы двух контактирующих в сверхрешетке монослоев из молекул типа В и С при ФР оптических возбуждений в этих молекулах, или аналогичный по топологии монослой из органических молекул, в каждой из которых существует ФР внутримолекулярных оптических колебаний, и, во-вторых, 3D-кристаллы из таких же органических молекул. При дальнейшем развитии результатов работ [11,12], полученных для 1D-кристаллов, будет показано, что в 2D и 3D кристаллических системах также существует несколько типов солитонных возбуждений с принципиально различной формой огибающих. Солитоны так называемого "пикового" (peak, (p)) типа имеют максимум огибающей в центре и последующее уменьшение огибающей до нуля при удалении к крыльям солитона. Солитоны "кратерного" (crater, (c)) типа имеют в центре относительный минимум, затем максимум на ближайших узлах решетки и уменьшение огибающей до нуля при удалении от центра солитона. "Темновые" (dark, (d)) солитоны имеют абсолютный минимум в центре солитона и асимптотическое возрастание с осцилляциями при приближении на крыльях к конечному асимптотическому пределу. При этом на крыльях солитонов p и cтипов для 2D и 3D, в отличие от солитонов, найденных в [11,12] для 1D-систем, может наблюдаться тонкая структура. Отметим, что дополнительно исследовалась зависимость огибающих от несущей частоты колебаний и расстройки ФР. Расчеты показали, что при приближении несущей частоты к полосе одночастичных возбуждений и при уменьшении расстройки ФР происходит уменьшение амплитуды и уширение солитонов, и возможно макроскопическое описание с использованием соответствующих нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка, что может быть актуально в связи с появлением в этом направлении ряда новых работ [13,14] и подготовкой интересных экспериментов.

Гамильтониан *H* кристаллической системы, состоящей из двух контактирующих двумерных монослоев молекул *B*- и *C*-типа или трехмерного кристалла из мономеров — молекул с ФР внутримолекулярных колебаний имеет вид

$$H = H_C + H_B + H_{\text{int}},\tag{1}$$

где H_C , H_B — гамильтонианы свободных экситонов *C*-и *B*-типа

$$H_{C} = \sum_{\mathbf{n}} \hbar \omega_{C} c_{\mathbf{n}}^{+} c_{\mathbf{n}} + \sum_{\mathbf{nm}} V_{\mathbf{nm}}^{(c)} c_{\mathbf{n}}^{+} c_{\mathbf{m}},$$
$$H_{B} = \sum_{\mathbf{n}} \hbar \omega_{B} b_{\mathbf{n}}^{+} b_{\mathbf{n}} + \sum_{\mathbf{nm}} V_{\mathbf{nm}}^{(b)} b_{\mathbf{n}}^{+} b_{\mathbf{m}}.$$
(2)

В (2) **n** = (n_x, n_y) для 2D и **n** = (n_x, n_y, n_z) для 3D-систем; b^+, c^+, b, c — Бозе-операторы рождения, уничтожения экситонов, $V_{nm}^{(c,b)}$ — матричные элементы операторов межмолекулярного взаимодейстия, определяющие трансляционное движение *c* и *b* экситонов. Гамильтониан H_{int} ангармонического *C* + *BB* взаимодействия 3-го порядка в (1), определяющий эффект ФР, имеет вид

$$H_{\text{int}} = \Gamma \sum_{\mathbf{n}} \left[\left(b_{\mathbf{n}}^{+} \right)^{2} c_{\mathbf{n}} + c_{\mathbf{n}}^{+} \left(b_{\mathbf{n}} \right)^{2} \right], \qquad (3)$$

где Γ — константа этого взаимодействия. Детальное обсуждение такого вида гамильтониана H_{int} приводится в [6].

Уравнения Гейзенберга для операторов b_{n}, c_{n}

$$i\hbar \frac{db_{\mathbf{n}}}{dt} = -[H, b_{\mathbf{n}}], \qquad i\hbar \frac{dc_{\mathbf{n}}}{dt} = -[H, c_{\mathbf{n}}] \qquad (4)$$

при взаимодействии ближайших соседей с учетом (1)–(3) имеют следующий вид:

$$i\hbar \frac{db_{\mathbf{n}}}{dt} = \hbar \omega_B b_{\mathbf{n}} + V_B \sum_{\mathbf{l}} b_{\mathbf{n}+\mathbf{l}} + 2\Gamma b_{\mathbf{n}}^+ c_{\mathbf{n}}, \qquad (5a)$$

$$i\hbar \frac{dc_{\mathbf{n}}}{dt} = \hbar\omega_C c_{\mathbf{n}} + V_C \sum_{\mathbf{l}} c_{\mathbf{n}+\mathbf{l}} + \Gamma b_{\mathbf{n}}^2, \tag{5b}$$

$$V_{\mathbf{n}\mathbf{m}}^{(b,c)} = V_{B,C}\delta_{\mathbf{n},\mathbf{m}+\mathbf{l}}.$$
 (5c)

Для описания нелинейных оптических возбуждений с большими числами заполнения при сильной лазерной накачке обычно используется квазиклассическое приближение, в рамках которого все операторы в (5) заменяются их средними значениями $\langle b_n \rangle \equiv B_n$, $\langle c_n \rangle \equiv C_n$, где B_n , C_n — амплитуды колебаний [6–12]. Будем искать решения системы уравнений для B_n , C_n , соответствующей (5), с временной зависимостью $B_n = B_n \exp(-i(\omega/2)t)$, $C_n = C_n \exp(-i\omega t)$ при действительных амплитудах B_n , C_n , ω — несущая частота. При такой временной зависимости система уравнений для B_n , C_n имеет вид

$$\frac{\hbar\omega}{2}B_{\mathbf{n}} = \hbar\omega_B B_{\mathbf{n}} + V_B \sum_{\mathbf{l}} B_{\mathbf{n}+\mathbf{l}} + 2\Gamma B_{\mathbf{n}} C_{\mathbf{n}}, \qquad (6a)$$

$$\hbar\omega C_{\mathbf{n}} = \hbar\omega_C C_{\mathbf{n}} + V_C \sum_{\mathbf{l}} C_{\mathbf{n}+\mathbf{l}} + \Gamma B_{\mathbf{n}}^2.$$
(6b)

Нетрудно видеть, что решения системы уравнений (6) B_n, C_n зависит от параметра Γ и \hbar как от масштабных множителей, и поэтому естественно ввести имеющие размерность частоты величины $b_n = (\Gamma/\hbar)B_n$, $c_n = (\Gamma/\hbar)C_n$. Для этих величин система соответствующих (6) уравнений имеет вид

$$\frac{\omega}{2}b_{\mathbf{n}} = \omega_B b_{\mathbf{n}} + \frac{V_B}{\hbar} \sum_{\mathbf{l}} b_{\mathbf{n}+\mathbf{l}} + 2b_{\mathbf{n}}c_{\mathbf{n}}, \qquad (7a)$$

$$\omega c_{\mathbf{n}} = \omega_C c_{\mathbf{n}} + \frac{V_C}{\hbar} \sum_{\mathbf{l}} c_{\mathbf{n}+\mathbf{l}} + b_{\mathbf{n}}^2. \tag{7b}$$

В [8–10] для одномерной системы аналитически было найдено солитонное решение системы уравнений (5) с огибающей известного вида — обратного гиперболического косинуса. При этом были найдены солитоны локализованного типа — "стоячие" солитоны — с нулевой скоростью перемещения максимума солитона v = 0 и бегущие солитоны с $v \neq 0$. Как следствие априорно предполагаемой гладкости огибающих и пропорциональности *В* и *С* амплитуд несущие частоты и скорости солитонов оказывались фиксированными величинами, определяемыми параметрами, входящими в (1)–(3). Далее будет показано, что в рассматриваемых двумерных и трехмерных кристаллах могут распространяться несколько солитонов различного типа. При этом в первую очередь рассматривались локализованные, "стоячие" солитоны.

На первом этапе исследовались азимутально и сферически симметричные солитонные решения. Соответственно последовательно рассматривались квадратные и кубические кластеры с выделенным центральным узлом и возрастающими нечетными полными числами узлов $N = N_2$ и $N = N_3$ соответственно для 2D- и 3D-систем. Для 2D-систем — $N_2 = 5, 9, 13, 21, \ldots$, для 3D-систем — $N_3 = 7, 19, 27, \ldots$, в соответствии с алгоритмом создания ближайших к центральному узлу окружностей и сфер с последовательно возрастающими радиусами. При этом радиальная зависимость амплитуд фиксируется одним индексом *r* по степени удаленности от центрального

узла. Для 2*D*-системы в дальнейшем в соответствии с этим принципом использовалась нумерация $b_0 \equiv b_{0,0}$; $b_1 \equiv b_{0,\pm 1} \equiv b_{\pm 1,0}$; $b_2 \equiv b_{\pm 1,\pm 1}$; $b_3 \equiv b_{\pm 2,0} \equiv b_{0,\pm 2}$; $b_4 \equiv b_{\pm 2,\pm 1} \equiv b_{\pm 1,\pm 2}$. Для 3*D*-системы использовалась нумерация $b_0 \equiv b_{0,0,0}$, $b_1 \equiv b_{\pm 1,0,0} \equiv b_{0,\pm 1,0} \equiv b_{0,0,\pm 1}$, $b_2 \equiv b_{0,\pm 1,\pm 1} \equiv b_{\pm 1,0,\pm 1} \equiv b_{\pm 1,\pm 1,0}$ и т.д. При этом соответствующие радиус-векторы этих узлов равны для 2*D*-системы $r_0 = 0$, $r_1 = a$, $r_2 = \sqrt{2}a$, $r_3 = 2a \dots$, для 3*D*-системы — $r_0 = 0$, $r_1 = a$, $r_2 = \sqrt{2}a$, $r_3 = \sqrt{3}a$ и т.д., где a — постоянная решетки. Величины r_i могут рассматриваться как радиусы соответствующих координационных окружностей (2*D*) или сфер (3*D*).

Для выделения основных аналитических особенностей огибающих солитонных возбуждений рассмотрим 2*D*-систему с наименьшим возможным числом узлов $N_2 = 5$. При этом уравнения (7) для b_n , c_n амплитуд имеют следующий вид:

$$\begin{pmatrix} \frac{\omega}{2} - \omega_B \end{pmatrix} b_0 - 4 \frac{V_B}{\hbar} b_1 = 2b_0 c_0, \ (\omega - \omega_C) c_0 - 4 \frac{V_C}{\hbar} c_1 = b_0^2,$$

$$\begin{pmatrix} \omega \\ 2 - \omega_B \end{pmatrix} b_1 - \frac{V_B}{\hbar} b_0 = 2b_1 c_1, \ (\omega - \omega_C) c_1 - \frac{V_C}{\hbar} c_0 = b_1^2.$$

$$(8b)$$

Эта система уравнений имеет точные аналитические решения. Будем для упрощения анализа полагать $V_A \equiv V_B \equiv \hbar V$. Выражая из первых уравнений (8*a*), (8*b*) c = c(b) как функции *b*, после подстановки во вторые уравнения (8*a*), (8*b*) получаем два нелинейных связанных уравнения для b_0 и b_1

$$2b_0^2 = (\omega - \omega_C) \left(\frac{\omega}{2} - \omega_B\right) - V(\omega - \omega_C)\frac{4}{x}$$
$$-4V \left(\frac{\omega}{2} - \omega_B\right) + 4V^2 x, \qquad (9a)$$
$$2b_1^2 = (\omega - \omega_C) \left(\frac{\omega}{2} - \omega_B\right) - V(\omega - \omega_C) x$$
$$-4V \left(\frac{\omega}{2} - \omega_B\right) + 4V^2 \frac{1}{x}, \qquad (9b)$$

где $x \equiv b_0/b_1$ — отношение амплитуд. Для величины x после деления (9a) на (9b) получаем уравнение 4-й степени

$$V(\omega - \omega_C)x^4 - (\omega - \omega_C - 4V)\left(\frac{\omega}{2} - \omega_B\right)x^3 + (\omega - \omega_C - 4V)\left(\frac{\omega}{2} - \omega_B\right)x - 4V(\omega - \omega_C) = 0.$$
(10)

Это уравнение имеет точные аналитические решения $x = x_i(\omega)$ со сложной зависимостью $x_i(\omega)$. Однако для солитонных решений с сильной локализацией возбуждений можно найти аппроксимирующие решения. Для пиковых солитонов с $x \gg 1$ в уравнении необходимо учесть только первые два члена. В результате для $x = x_p$ получаем следующее выражение:

$$x_p = \frac{\left(\omega - \omega_C - 4V\right)\left(\frac{\omega}{2} - \omega_B\right)}{V(\omega - \omega_C)} > 1.$$
(11)

Для темнового солитона $x \ll 1$, в уравнении необходимо учесть только последние два члена и, соответственно, для $x = x_d$ получаем

$$x_d = \frac{4V(\omega - \omega_C)}{(\omega - \omega_C - 4V)\left(\frac{\omega}{2} - \omega_B\right)} < 1.$$
(12)

Наконец для солитонов кратерного типа с $x \approx 1$ необходимо учитывать все члены, но можно произвести разложение по малому отклонению δ величины x от единицы, $x = 1 + \delta$, $\delta \ll 1$. В результате получаем для $x = x_c$ следующее соотношение:

$$\delta = \frac{3V(\omega - \omega_C)}{4V(\omega - \omega_C) - 2(\omega - \omega_C - 4V)\left(\frac{\omega}{2} - \omega_B\right)} < 1,$$
$$x_c = 1 + \delta. \tag{13}$$

Неравенства в соотношениях (11)-(13) определяют области существования солитонов и соответствующие пороги. Величины b_0 и b_1 для солитонов всех трех типов получаются из соотношений (7) при использовании найденных при решении (9) значений x_p , x_d , x_c . Расчеты для 3D-системы с минимальным числом узлов $N_3 = 7$ аналогичные (8)–(13) дают такие же соотношения для амплитуд с небольшими численными поправками. Как показали дальнейшие расчеты, при увеличении N происходит только наращивание крыльев этих солитонов с базовыми значениями b_0 , b_1 , полученными таким образом. Вместе с тем далее будет отмечено, что у крыльев солитонов в 2D- и 3D-системах появляется определенная, отсутствующая у 1D-солитонов [11,12], немонотонность с замедлением спадания и локальными максимумами.

Аналитические расчеты огибающих солитонов для систем с N₂ > 5, N₃ > 7 являются достаточно сложной задачей, поэтому для таких систем на PC PENTIUM были проведены численные расчеты решений системы нелинейных уравнений для $b_{\mathbf{n}}$, полученных из (7) после подстановки в (7*b*) $c_{\mathbf{n}} = c_{\mathbf{n}}(b_{\{m\}})$ как функций $b_{\mathbf{n}}$ и ближайших bm. Сами уравнения здесь не приводятся из-за громоздкой нелинейной связи c_n с различными b_m . Расчеты велись параллельно для 1D-, 2D- и 3D-систем. При этом в 1D-системе, соответствующей одномерному кластеру, расчеты велись до 7-го узла, удаленного от центрального на расстояние 7а, в 2D-системе — до 8-й координационной окружности, в 3D-системе — до 10-й координационной сферы. На рис. 1, 2, 3 для 1D-системы для сравнения с 2D- и 3D-системами приведены только центральные части огибающих до n = 4. Различное число координационных сфер и окружностей было использовано для отслеживания пульсаций на крыльях солитонов при различных *г*.

На рис. 1, 2, 3 приведены результаты расчетов радиальной зависимости огибающих b_r для солитонов p — пикового типа (рис. 1), c — кратерного типа (рис. 2), и d — темнового типа (рис. 3). Отметим, что значения радиусов r для систем различной размерности отличаются: в 1*D*-системе — $r = r_i = ia$, в



Рис. 1. Радиальная зависимость огибающих солитонов пикового типа в 1*D*, 2*D*, 3*D* кристаллических системах.

2*D*-системе — $r = r_{ij} = (i^2 + j^2)^{1/2} a$, в 3*D*-системе — $r = r_{ijk} = (i^2 + j^2 + k^2)^{1/2} a$, где индексы i, j, k нумеруют узлы кристалла. Поскольку для некоторых из полученных зависимостей b_r значения функции при разных r, $0 \leqslant r \leqslant 7$, различаются на 5–10 порядков, для визуального восприятия результатов на рис. 1, 2, 3 представлена зависимость от r функции $(b_r)^{1/4}$, монотонно отображающей b_r с относительным увеличением малых значений функции и относительным уменьшением больших значений функции. Все частотные характеристики выражались в единицах ω_C . Значения параметров выбирались близкими к реальным оптическим параметрам $V_B/\hbar\omega_C = V_C/\hbar\omega_C = 0.01, \ \omega_B/\omega_C = 0.4,$ использованным в [4,9-12]. В [11,12] отмечалось, что для несущей частоты в 1D-системах существуют пороговые ω , при превышении которых появляются солитоны различного типа. Аналогичная ситуация наблюдается в 2D- и 3D-кристаллах. При используемых параметрах нижние пороговые значения несущей частоты $\omega = \omega_0$, при которых появляются d- и c-солитоны, равняются в 1*D*-системе $\omega_0/\omega_C~\cong~1.02$, в 2*D*-системе — $\omega_0/\omega_C \cong 1.14$, в 3*D*-системе — $\omega_0/\omega_C \cong 1.54$. Для одновременного графического представления 1D-, 2D- и 3D-системы выбиралось значение параметра $\omega/\omega_{C} = 1.7$. На рис. 1 видно, что в отличие от 1D огибающие p-солитона для 2D- и 3D-систем имеют локальные максимумы и замедление спадания при определенных значениях г. Эти значения г отвечают точкам на кристаллографических осях (i, 0), (0, i),i = 2, 3... в 2*D*-системе. В 3*D*-системе локальные максимумы наблюдаются в точках (i, j, 0), (i, 0, j), (0, i, j),i, j = 2, 3... Значения огибающих в точках (i, 0), (0, i) 2D-системы $b_r = b_{i,0} = b_{0,i}$ и в точках (i, 0, 0), (0, i, 0), (0, 0, i) 3D-системы $b_r = b_{i00} = b_{0i0} = b_{00i}$ близки к значениям огибающей $b_r = b_i$ в 1*D*-системе. Значения огибающей $b_r = b_{ij0} = b_{i0j} = b_{0ij}$ в 3*D*-системе близки к значениям $b_r = b_{ij}$ в 2D-системе. Последнее связано с чрезвычайно малым значением $V/\hbar\omega_C = 0.01$ для оптических систем, большим удалением ω от ω_C ,

большой расстройкой ферми-резонанса $\omega_C - 2\omega_B$, но при больших V, меньших удалениях ω от ω_C , меньших расстройках ΦP эти значения различаются более существенно. Проведенные качественные аналитические расчеты показали, что отмеченные выше локальные максимумы и замедления спадания на огибающих связаны с тем обстоятельством, что, например, в 2D-системе молекула с r = 6 взаимодействует с молекулой низшей координационной окружности r = 3 и соответственно ее амплитуда возрастает по сравнению с амплитудой молекулы r = 5, взаимодействующей с молекулой r = 4. Такие же ситуации наблюдаются и в других случаях, в 2D- и 3D-кристаллах.

На рис. 2, представляющем кривые огибающих с-солитона, видно, что при r = 0 значения амплитуд в центре для 1*D*-, 2*D*-, 3*D*-систем находятся в отношении $b_0 > b_{00} > b_{000}$ (в прежней индексации). Начиная со следующей координационной окружности, или сферы, r = 1, т.е. на спадающем участке зависимостей b_r , поведение огибающих *с*-солитона имеет те же особенности, что и поведение огибающих *p*-солитона. При этом, однако, пульсации на крыльях солитонов имеют большие по сравнению с рис. 1 амплитуды.



Рис. 2. Радиальная зависимость огибающих солитонов кратерного типа в 1*D*, 2*D*, 3*D* кристаллических системах.



Рис. 3. Радиальная зависимость огибающих солитонов темнового типа в 1*D*, 2*D*, 3*D* кристаллических системах.

На рис. 3, представляющем кривые огибающих *d*-солитона, видно, что для r = 0 величины $b_0 < b_{00} < b_{000}$, а для r = 1 величины огибающих находятся в противоположном соотношении $b_1 > b_{10} > b_{100}$. На участке зависимости r > 1 кривые огибающих *d*-солитона имеют минимум, а затем выходят асимптотически на постоянное конечное значение, и, таким образом, в 2D-и 3D-системах наблюдается та же закономерность, что и отмеченная в 1D-системе в работе [11].

Отметим также, что полученные численные значения огибающих p-, c-, d-солитонов 2D-системы в центральной точке и первой координационной окружности совпадают, с малой погрешностью, со значениями, полученными из аналитических соотношений (10)–(13), что служит одновременным подтверждением применимости как использованных численных программ, так и аналитических процедур соответствующих разложений.

Отметим, что представленные радиальные зависимости b_r дают только ориентирующее визуальное представление о действительном структурировании по кристаллографическим направлениям естественно более богатой пространственной зависимости амплитуд колебаний в 2D и 3D кристаллических решетках. Представляют интерес уже развивающиеся исследования азимутальной зависимости огибающих солитонов [13,14] и начинающиеся экспериментальные исследования в этой области. В статье основное внимание уделялось пиковым, кратерным и темновым солитонам. Необходимо, по-видимому, провести аналогичные исследования и для солитонов качественно других типов, впервые исследованных в работах авторов [11,12].

В заключение авторы выражают искреннюю признательность В.М. Аграновичу за полезные замечания.

Работа выполнена при поддержке Российской государственной научно-технической программы "Актуальные направления в физике конденсированных сред" по направлению "Нейтронные исследования вещества". (О.А.Д.) благодарит за частичную поддержку по гранту Фольксваген Фонда I/69928.

Список литературы

- F.F. So, S.R. Forrest, Y.Q. Shy, W.H. Steier. Appl. Phys. Lett. 56, 7, 674 (1990).
- [2] F.F. So, S.R. Forrest. Phys. Rev. Lett. 66, 20, 2649 (1991).
- [3] V.M. Agranovich. Mol. Liq. Cryst. 230, 1, 13 (1993).
- [4] V.M. Agranovich, R.D. Atanasov, G.F. Bassani. Chem. Phys. Lett. 199, 6, 621 (1992).
- [5] V.M. Agranovich. Physica Scripta **T49**, *5*, 699 (1993).
- [6] V.M. Agranovich, O.A. Dubovsky. Chem. Phys. Lett. 210, 4–6, 458 (1993).
- [7] V.M. Agranovich, J.B. Page. Phys. Lett. A183, 5/6, 651 (1993).
- [8] В.М. Агранович, А.М. Камчатнов. Письма в ЖЭТФ 59, 6, 397 (1994).
- [9] V.M. Agranovich, O.A. Dubovsky, A.M. Kamchatnov. J. Phys. Chem. 98, 51, 13607 (1994).

[10] V.M. Agranovich, S.A. Darmanyan, O.A. Dubovsky,

О.А. Дубовский, А.В. Орлов

- A.M. Kamchatnov, E.I. Ogievetsky, P. Reineker, Th. Neidlinger. Phys. Rev. **B53**, 23, 15451 (1996).
- [11] О.А. Дубовский, А.В. Орлов. ФТТ 38, 4, 1221 (1996).
- [12] О.А. Дубовский, А.В. Орлов. ФТТ **38**, *6*, 1931 (1996).
- [13] S. Darmanyan, A. Kobyakov, F. Lederer. Phys. Rev. E57, 2, 957 (1998).
- [14] V.M. Agranovich, S.A. Darmanyan, K.I. Grigorishin, A.M. Kamchatnov, Th. Neidlinger, P. Reineker. Phys. Rev. B57, 26, 2461 (1998).
- [15] В.М. Агранович, Й.Й. Лалов. УФН 146, 2, 267 (1985).
- [16] О.А. Дубовский, А.В. Орлов. ФТТ **39**, *3*, 542 (1997).